

Учебный план основной образовательной программы

Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии

по направлению 03.04.02 «Физика»

Уровень: Магистратура
 Квалификация: магистр
 очная форма обучения
 2024 год приема

НТС ИФИБ НИЯУ МИФИ.
 Протокол №4.1 от 28.08.2023

1. График учебного процесса

Годы	Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
1			1-7 сент.	8-14 сент.	15-21 сент.	22-28 сент.	29 сент.-5 окт.	6-12 окт.	13-19 окт.	20-26 окт.	27 окт.- 2 нояб.	3-9 нояб.	10-16 нояб.	17-23 нояб.	24-30 нояб.	1-7 дек.	8-14 дек.	15-21 дек.	22-28 дек.	29 дек.-4 янв.	5-11 янв.	12-18 янв.	19-25 янв.	26 янв.-1 фев.	2-8 февр.	9-15 февр.	16-22 февр.	23 февр.- 1 марта	2-8 марта	9-15 марта	16-22 марта	23-29 марта	30 марта-5 апр.	6-12 апр.	13-19 апр.	20-26 апр.	27 апр.-3 мая	4-10 мая	11-17 мая	18-24 мая	25-31 мая	1-7 июня	8-14 июня	15-21 июня	22-28 июня	29 июня-5 июля	6-12 июля	13-19 июля	20-26 июля	27 июля- 2 авг.	3-9 авг.	10-16 авг.	17-23 авг.	24-30 авг.
2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т			

Т – теоретическое обучение, Э – экзаменационная сессия, К – каникулы, П – практика, Д – выпускная квалификационная работа

Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры																		Практическая подготовка	Компетенции							
					1 курс									2 курс																	
					1 18 нед (ТО: 18 нед)					2 17 нед (ТО: 17 нед)				3 18 нед (ТО: 18 нед)					4 6 нед (ТО: 6 нед)												
					Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт			Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	
Б1.ДВ.2.10	Ф Взаимодействие лазерного излучения с веществом	88	4	144								53	15	30	8	55	Э(36)											8	ук-3, пк-7, пк-4.2, пк-4.1		
Б1.ДВ.2.11	Ф Б1.ДВ.2.11.1 Современная оптика (Modern Optics) Б1.ДВ.2.11.2 Волоконная оптика и волоконные лазеры	88	2	72																				24	6	18		48	3		ук-6, пк-4.2, пк-4.1
Б1.ДВ.2.12	Ф Физическая оптика	88	8	288	32	16	16			76	Э(36)	30	15	15			78	Э(36)												ук-6, пк-4.2, пк-4.1	
Б1.ДВ.2.13	Ф Б1.ДВ.2.13.1 Оптика твердого тела Б1.ДВ.2.13.2 Физика твердого тела применительно к наноструктурам	88 87	5	180	56	16	32	8	88	Э(36)																			8	ук-3, ук-6, пк-4.1	
Б1.ДВ.2.14	Ф Б1.ДВ.2.14.1 Актуальные проблемы квантовой электроники Б1.ДВ.2.14.2 Современные лазерные технологии	88	3	108														32	8	24			76	3, К/р					ук-3, пк-7, пк-4.2, пк-4.7, пк-4.1		
Б1.ДВ.2.15	Ф Постростовая технология производства полупроводниковых лазеров	88	2	72														32	16	16			40	3					пк-2, пк-3, пк-7, пк-4.1, пк-4.5, пк-4.3		
Б1.ДВ.2.16	Ф Лазерные и фотонные нанотехнологии для наномедицины (Lazer and Photonic Nanotechnologies for Nanomedicine)	85	2	72														30	22	8			42	3					ук-6, пк-4.2, пк-4.1		
Б2	Практика		40	1440																											
Б2.ОД	Базовая часть		25	900																											
Б2.ОД.1	О Учебная практика (педагогическая)	88	7	252														36					144	3	30		42	3/0	66	ук-1, ук-2, ук-3, ук-4, ук-6, опк-1, опк-2, опк-3, опк-4, пк-1, пк-2, пк-3, пк-4, пк-5, пк-6, пк-7, укц-1	
Б2.ОД.2	О Производственная практика (получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)	88	4	144								30					78	Э(36)											30	ук-1, ук-6, опк-1, опк-2, опк-3, опк-4, пк-1, пк-2, пк-6, пк-7, укц-1, укц-2	
Б2.ОД.3	О Производственная практика (научно-исследовательская работа)	88	14	504								30					186	3	32						112	Э(36)	18	54	Э(36)	80	ук-1, ук-2, ук-3, ук-4, ук-5, ук-6, опк-1, опк-2, опк-3, опк-4, пк-1, пк-2, пк-3, пк-6, пк-7, укц-1, укц-2
Б2.ДВ	Вариативная часть		15	540																											
Б2.ДВ.1	Ф Производственная практика (преддипломная)	88	15	540																							540	3/0	540	ук-1, ук-2, ук-3, ук-4, ук-5, ук-6, пк-1, пк-2, пк-3, пк-6, пк-7, укц-1, укц-2, пк-4.2, пк-4.4, пк-4.7, пк-4.1, пк-4.5, пк-4.3	
Б3	Государственная итоговая аттестация		6	216																											

